

## FMN-4206S

Fast Recovery Diode

2010年1月

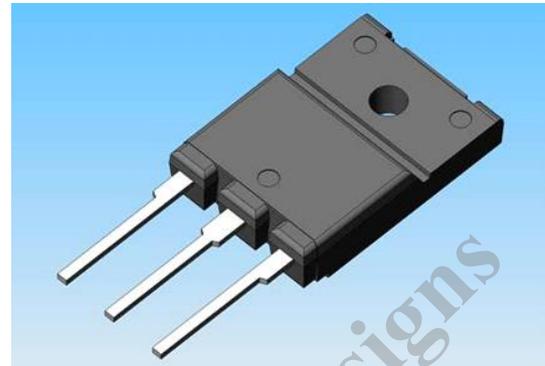
### 概要

高速性はそこそこで低VFを重視したFRDを、大電流パッケージであるTO-3PFに組み込みました。低VFと程よい高速性でソフトスイッチングを実現。回路の低ノイズ化にも貢献します。

### アプリケーション

- ・ DCM方式PFC回路（不連続方式力率改善回路）
- ・ DC-DCコンバータ（電流共振方式）

### パッケージ (TO-3PF 3pin)



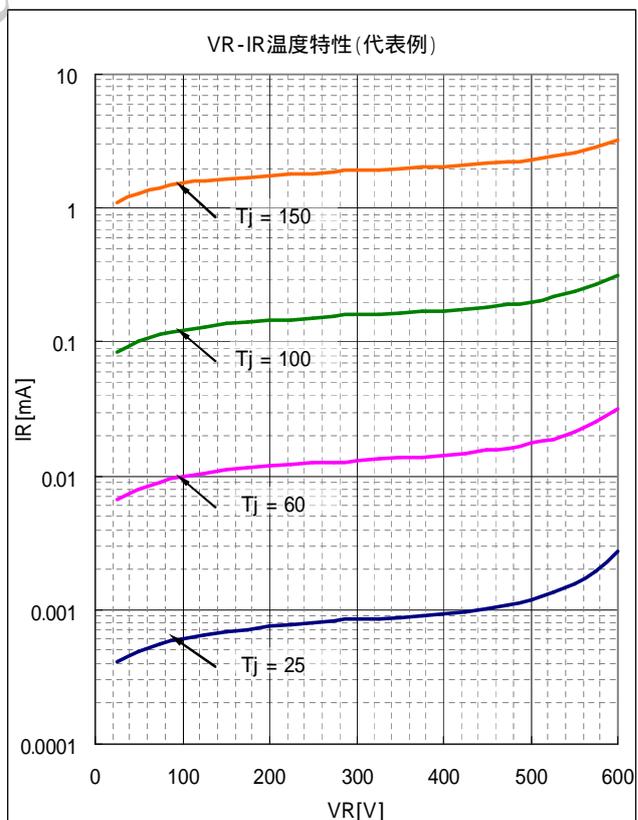
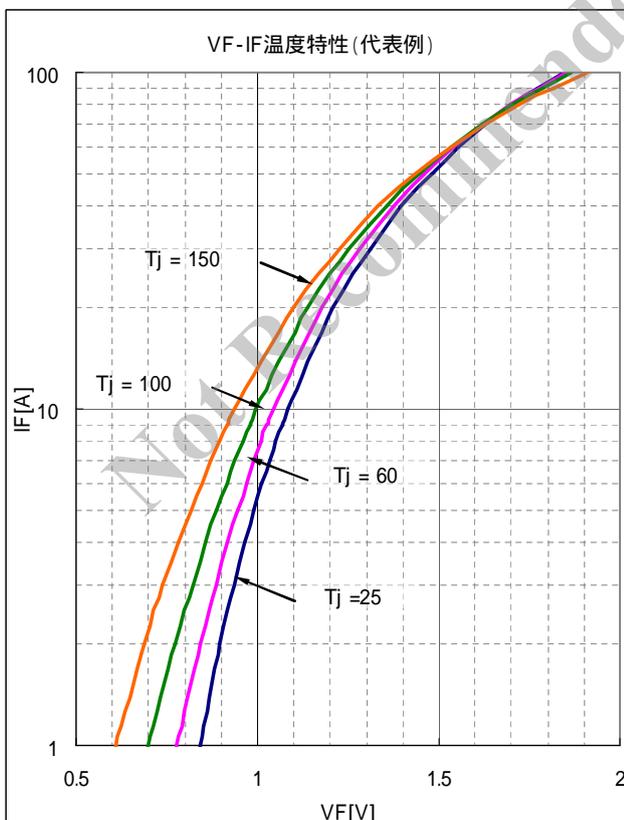
### 特長

- ・ 低VF重視のFRD
- ・ 程よい高速性によるソフトスイッチング
- ・ 大電流パッケージによる優れた放熱性
- ・ フルモールドパッケージによる優れた絶縁性

### 主要スペック

項目	記号	単位	定格	条件
ピーク線り返し逆電圧	$V_{RM}$	V	600	
順方向降下電圧	$V_F$	V	1.3	$I_F=10A$
平均順電流	$I_{F(AV)}$	A	20	
逆方向回復時間	$t_{rr1}$	ns	100	
	$t_{rr2}$	ns	50	

### 代表特性



VF-IF・VR-IR 共に、一素子当たりの特性を示す。

記載されている内容は改良などにより予告なく変更することがあります。ご使用の際には、最新の情報であることをご確認ください。

**FMN-4206S**

2010年1月

Fast Recovery Diode

★ 絶対最大定格

No.	項目	記号	単位	定格	条件
1	ピーク非繰返し逆電圧	$V_{RSM}$	V	600	
2	ピーク繰返し逆電圧	$V_{RM}$	V	600	
3	平均順電流	$I_{F(AV)}$	A	20	減定格の項を参照(ページ3)
4	サージ順電流	$I_{FSM}$	A	150	10msec. 正弦半波単発
5	$I^2t$ 限界値	$I^2t$	A <sup>2</sup> s	112.5	1msec t 10msec
6	接合部温度	$T_j$		-40 ~ +150	
7	保存温度	$T_{stg}$		-40 ~ +150	

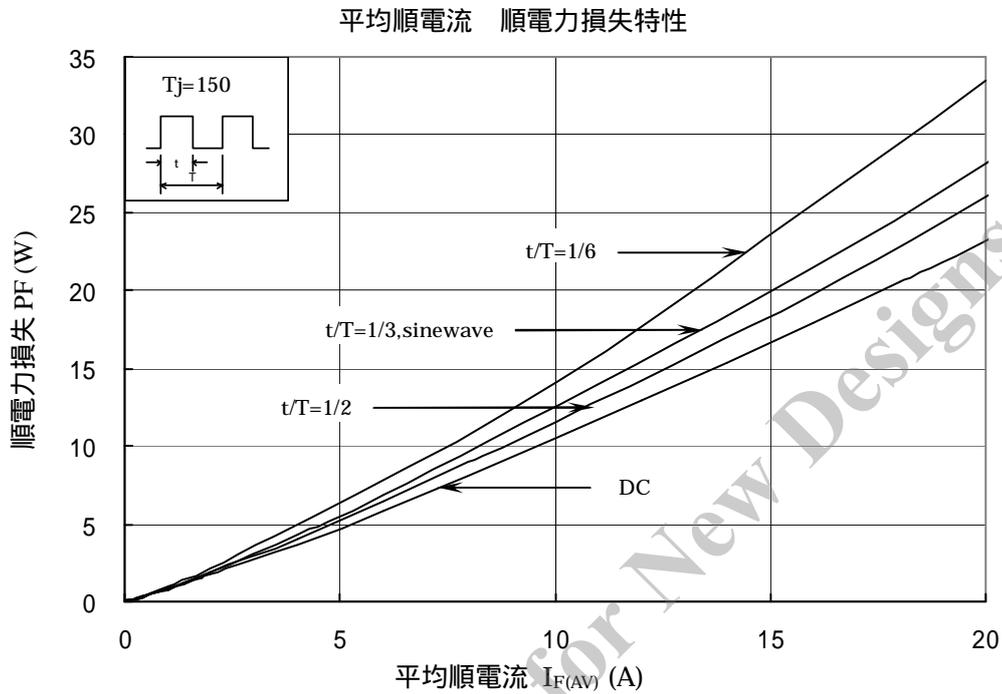
No.1,2,4,5 は一素子当たりの特性を示す。

★ 電気的特性(特に指定の無い場合は、25 とする。)

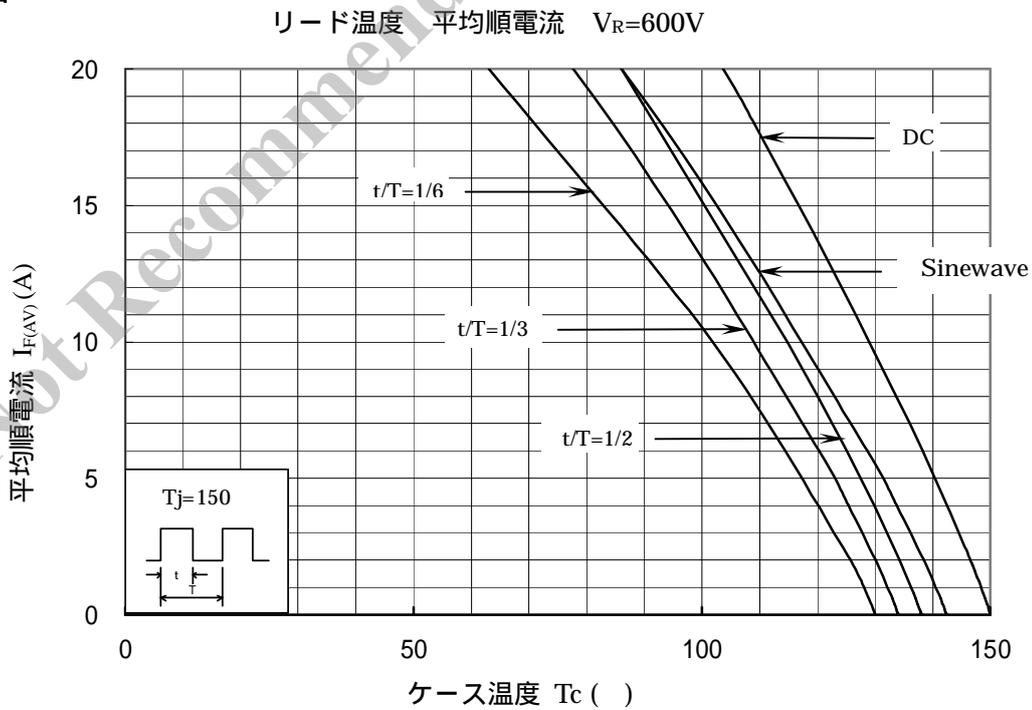
No.	項目	記号	単位	特性	条件
1	順方向降下電圧	$V_F$	V	1.5 max.	$I_F=10A$
2	逆方向漏れ電流	$I_R$	uA	100 max.	$V_R=V_{RM}$
3	高温逆方向漏れ電流	$H \cdot I_R$	mA	20 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=150$
4	逆方向回復時間	$t_{rr1}$	ns	100 max.	$I_F=I_{RP}=100mA$ 90% Recovery point, $T_j=25$
		$t_{rr2}$	ns	50 max.	$I_F=100mA, I_{RP}=200mA$ 75% Recovery point, $T_j=25$
5	熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	/W	2.0 max.	接合部 - ケース間

No.1,2,3,4 は一素子当たりの特性を示す。

★ 特性



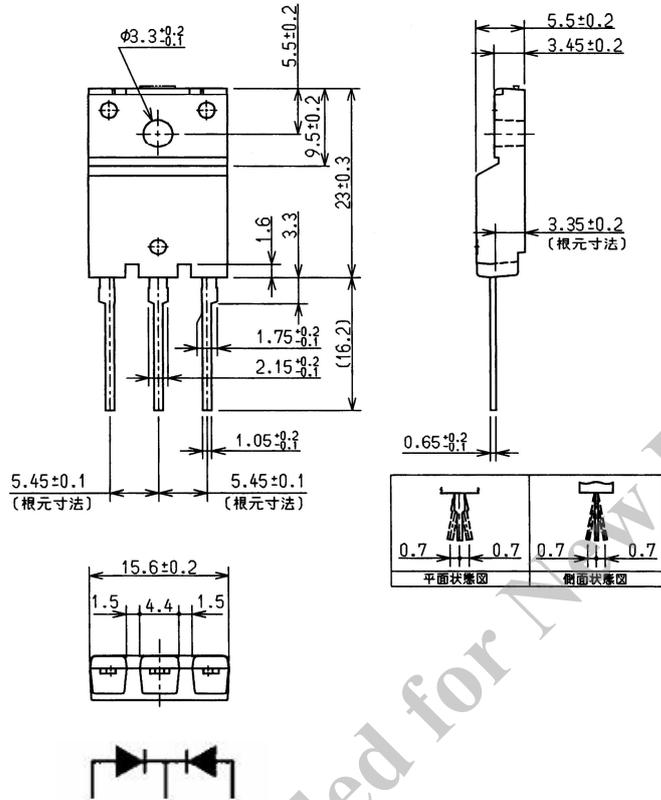
★ 減定格



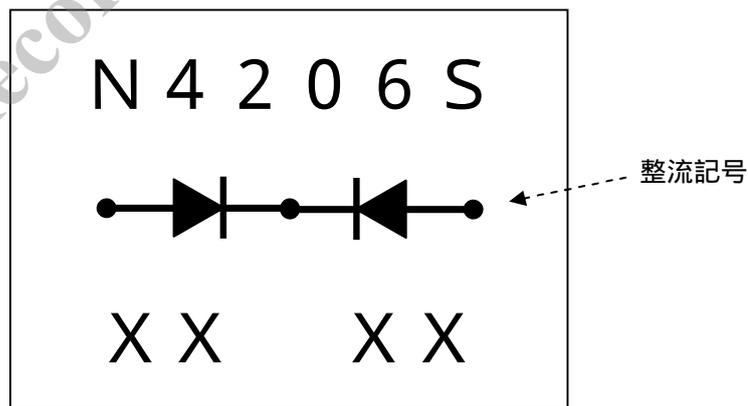
**FMN-4206S**  
Fast Recovery Diode

2010年1月

★ 外形図 (mm)



★ マーク表示



N4206S : 品名 FMN-4206S を “N4206S” と表す  
XXXX : ロット番号 (製造年月日) を 4 桁で表す